

概述与特点

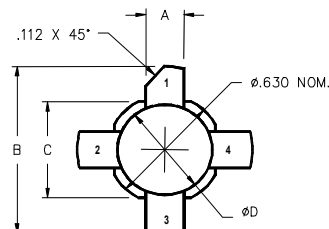
3DA92 硅 NPN 型超高频大功率晶体管，主要用于 VHF 电视发射机与差转机以及通讯等其他电子设备中作射频功率放大。该产品具有良好的电性能和可靠性。

本型号的主设计师是原华晶四分厂总工王道修，他也是我司的创始人兼技术总监。

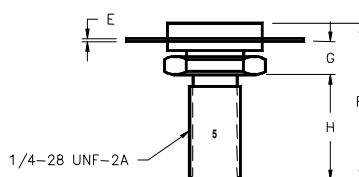
- 1) 工作频率高
- 2) 电流特性好
- 3) 二次击穿耐量高

外形尺寸

UNIT	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	5.59	26.67	13.84	12.57	0.08	20.57	4.70	12.62
	5.84		14.10	12.83	0.18		5.03	13.46
inches	0.22	1.050	0.545	0.495	0.003	0.810	0.185	0.497
	0.23		0.555	0.505	0.007		0.198	0.530



1. Collector
2. EMITTER
3. BASE
4. EMITTER
5. FIN



NOTE: ALL ELECTRODES ARE ISOLATED FROM FLANGE.

极限值

参数名称	符号	额定值		单位
		C	L	
集电极-发射极电压	V_{CE0}	40	45	V
集电极-基极电压	V_{CB0}	60	70	V
发射极-基极电压	V_{EB0}	4		V
集电极电流	I_C	1.5		A
耗散功率 ($T_c=25$)	P_{tot}	20		W
结温	T_j	150		$^{\circ}C$
贮存温度	T_{stg}	-55~+150		$^{\circ}C$

电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=40V$ $I_E=0$			1.5	mA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=3V$ $I_C=0$			1.5	mA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5V$ $I_C=0.5A$	C 15	L 20	100 60	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE sat}$	$I_C=1A$ $I_B=0.2A$			1	V
输出功率	P_O	$V_{CC}=28V$ $P_I=3W$ $f=400MHz$	10	12.5		W
功率增益	G_p	$V_{CC}=28V$ $P_O=10W$ $f=400MHz$	5	6		dB
输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=28V$ $I_E=0$ $f=1MHz$			25	pF

Note : Above parameters , ratings , limits and conditions are subject to change.